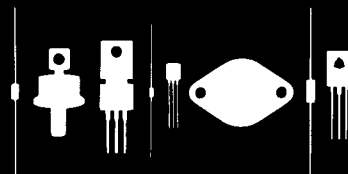


Central
Semiconductor Corp.
Central
Semiconductor Corp.
CentralTM
Semiconductor Corp.

145 Adams Avenue
Hauppauge, New York 11788



2N5814 2N5816 2N5818 NPN
2N5815 2N5817 2N5819 PNP

COMPLEMENTARY SILICON
TRANSISTORS

T0-92-18R CASE

DESCRIPTION

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N5814 Series types are epoxy molded Complementary Silicon Small Signal Transistors manufactured by the epitaxial Planar process designed for general purpose amplifier applications where a high collector current rating is required.

MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL		UNIT
Collector Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector Emitter Voltage	V_{CES}	50	V
Collector Emitter Voltage	V_{CEO}	40	V
Emitter Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current	I_C	750	mA
Collector Current (PEAK)	I_{CM}	1000	mA
Power Dissipation	P_D	625	mW
Power Dissipation ($T_C=25^\circ\text{C}$)	P_D	1500	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 TO +150	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNIT
T_{CBO}	$V_{CB}=25\text{V}$		TOO	nA
I_{CBO}	$V_{CB}=25\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$		15	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=5.0\text{V}$		10	μA
BV_{CES}	$I_C=10\mu\text{A}$	50		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$	40		V
BV_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	5.0		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		0.75	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		1.2	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=500\text{mA}$	0.60	1.1	V
h_{FE}	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$ (2N5814, 2N5815)	60	120	
h_{FE}	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$ (2N5816, 2N5817)	100	200	
h_{FE}	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$ (2N5818, 2N5819)	150	300	
h_{FE}	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=500\text{mA}$ (2N5814, 2N5815)	20	-	
h_{FE}	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=500\text{mA}$ (2N5816, 2N5817)	25	-	
h_{FE}	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=500\text{mA}$ (2N5818, 2N5819)	25	-	
f_T	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=50\text{mA}, f=20\text{MHz}$ (2N5814, 2N5815)	100		MHz
f_T	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=50\text{mA}, f=20\text{MHz}$ (2N5816, 2N5817)	120		MHz
f_T	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=50\text{mA}, f=20\text{MHz}$ (2N5818, 2N5819)	135		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		15	pF
C_{ib}	$V_{EB}=0.5\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		55	pF

CentralTM
Semiconductor Corp.

145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Tel: (631) 435-1110 • Fax: (631) 435-1824
www.centralsemi.com

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Central Semiconductor:](#)

[2N5817](#) [2N5819](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9